

半导体学报

第6卷 第4期 1985年7月

目 录

- 半导体超晶格-绝缘介质-半导体超晶格夹层结构中的表面电子集体激发谱..... 秦国毅 (339)
采用半导体器件的高压纳秒脉冲电路..... 李锦林 周 旋 鲍秉乾 (350)
非晶态砷化镓薄膜的研制..... 吴汝麟 陈坤基 杨左娅 (355)
GaAs 和 Si 的电子亲合势和功函数的比较研究 邢益荣 W. Ranke (362)
双极型晶体管交流模型参数的优化提取..... 夏武颖 郑 颖 (369)
Si(100) 面的红宝石激光辐照氧化问题 许振嘉 陈维德 (379)
LPE-GaAs 中 0.72eV 电子陷阱与生长条件的关系
- 杨锡权 向贤碧 吴让元 (386)
双层多晶硅电极间隙势垒的两维分析..... 王守武 何乃明 夏永伟 (393)
离子注入型蓝光灵敏的光电探测器.....
..... 孙宝寅 刘玉兰 李文年 江剑平 王振明 (406)
外延 GaAs 平面 Hall 器件 郑一阳 张进昌 刘衍芳 (413)

研 究 简 报

- GD 类多晶硅薄膜的电导特性 何宇亮 邵 达 马晓娟 (420)
反应离子束刻蚀二氧化硅和硅研究.....
..... 傅新定 陈国明 任稼欣 郑延芳 陈莉芝 方红丽 杨 洁 (423)
InP 上等离子增强化学汽相沉积 SiO_2 膜及其 MIS 结构 C-V 特性研究
- 江若琏 徐俊明 刘青淮 王 凯 郑有炡 (429)
半绝缘砷化镓材料的铍离子注入 周 勉 史常忻 (433)
原子氢钝化硅中与铜有关的缺陷 王忠安 陈开茅 秦国刚 (437)
分段压缩平面共腔条形激光器的进展 杜国同 杨德林 高鼎三 (442)
掺杂超晶格——Si-nipi 结构中的电子态 王恩哥 黄和鸾 (446)